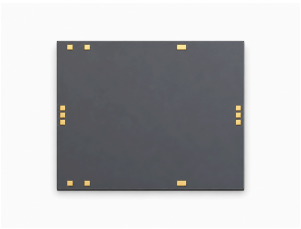
Die amplificador de potência GaN MMIC de 950–1250 MHz

LCI-PA-950-1250-PS47p5T é um amplificador de potência GaN MMIC em die sem encapsulamento para 950–1250 MHz. Permite operação em CW e pulsada.



Valores da tabela RF: Potência de saída saturada: 47.5 dBm (típico); Ganho de potência: 22.5 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 60 % (típico). Condições de teste RF: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V. Dimensões do die: 4.35 × 3.43 × 0.1 mm.

Características RF

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Frequência de operação	f	950	-	1250	MHz
Potência de saída saturada	Psat	47	47.5	-	dBm
Ganho de potência	Gp	22	22.5	-	dB
Planicidade do ganho de potência	ΔGp	-	-	±0.3	dB
Eficiência de potência adicionada	PAE	-	60	-	%
Ganho de pequenos sinais	S21	-	35	-	dB
Planicidade do ganho de pequenos sinais	ΔS21	-	-	±1	dB
VSWR de entrada	VSWR(in)	-	1.6	2	-

Polarização DC e correntes

TA = +25 °C

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Tensão de dreno	Vd	-	28	36	V
Tensão de porta	Vg	-3.2	-3	-2.8	V
Corrente de dreno em repouso	Id	-	1	-	A
Corrente dinâmica de dreno	Idd	-	3.5	3.8	A
Corrente dinâmica de porta	Igg	-	1	3	mA

Valores limite

Valores limite; não são pontos de operação normal.

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Tensão dreno-fonte máxima	Vd	-	-	36	V
Polarização mínima da porta	Vg	-5	-	-	V
Potência de entrada máxima	Pin	-	-	30	dBm
Temperatura máxima do canal	Top	-	-	225	°C

Valores limite

Valores limite; não são pontos de operação normal.

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Temperatura de armazenamento	TSTG	-65	-	150	°C

Dimensões do die

Parâmetro	Valor	Unidade
Dimensões do die	4.35 × 3.43 × 0.1	mm
Tolerância do contorno em planta	±100 (Somente contorno em planta; a tolerância da espessura não está especificada.)	µm

Registro da publicação atual · 1.8 · 2026-11-12. Atualização da descrição ou do conteúdo editorial. Substitui a revisão 1.7.

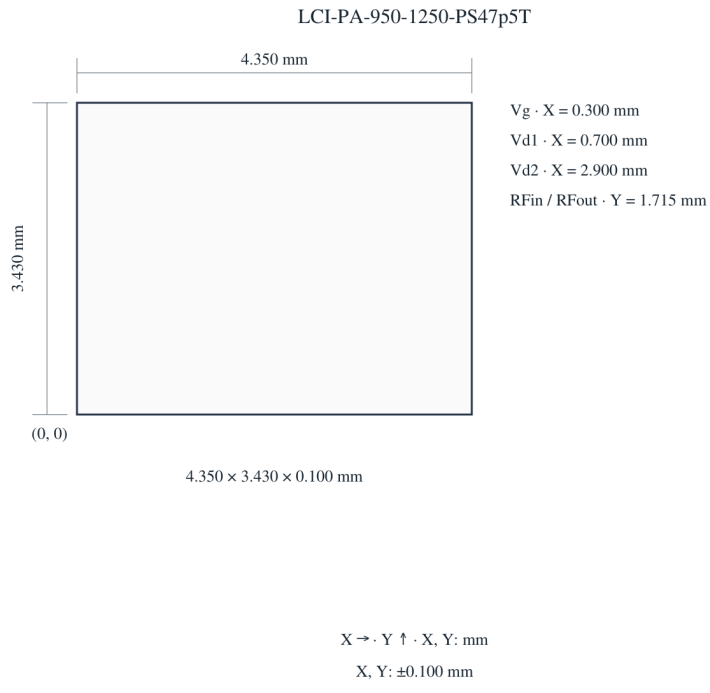
Integração do die e sequência de polarização

Ao ligar, aplicar a polarização de porta antes da de dreno. Ao desligar, remover primeiro a polarização de dreno. Manusear em ambiente limpo com proteção ESD e usar um suporte com expansão térmica compatível com o die de SiC. Contorno e coordenadas cotadas em mm. Este desenho serve como referência dimensional. A fabricação e a interconexão por fios exigem desenhos completos.

Dimensões dos pads de ligação

RFin: 100 × 100 µm; Vg: 120 × 100 µm; Vd1: 120 × 100 µm; Vd2: 200 × 100 µm; RFout: 100 × 120 µm.

Desenho dimensional mecânico

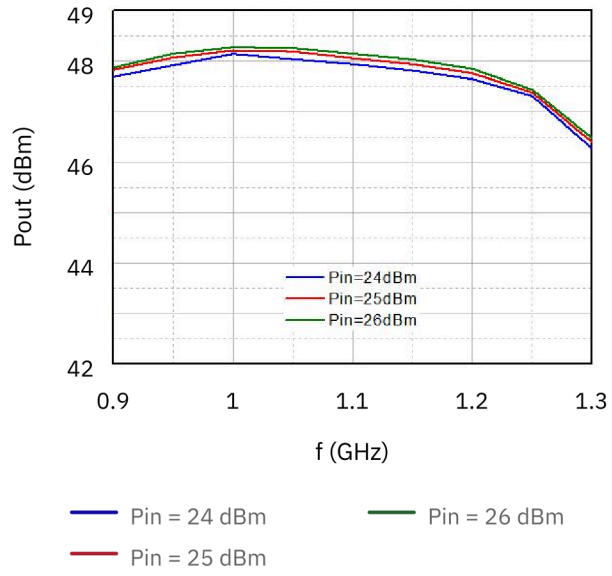


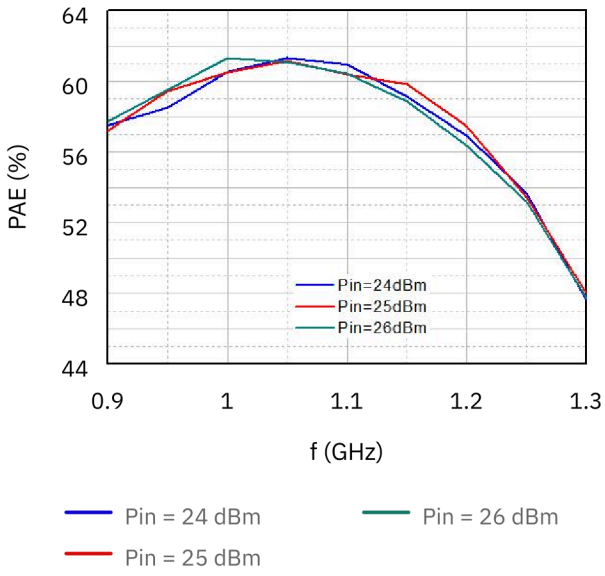
Curvas de desempenho

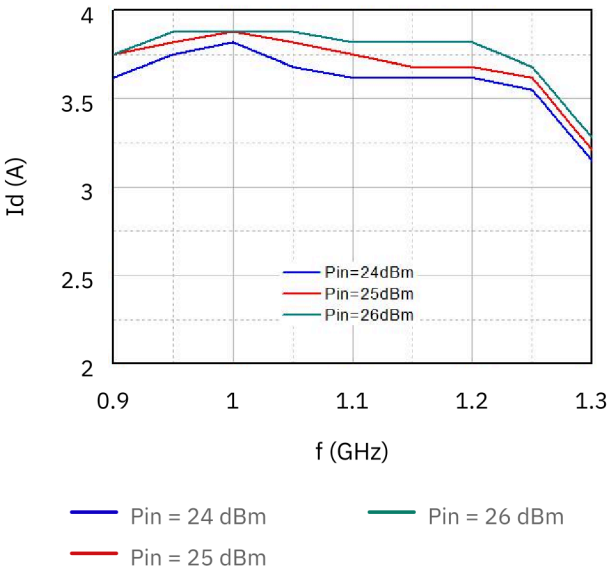
Considere as condições de operação indicadas em cada figura.

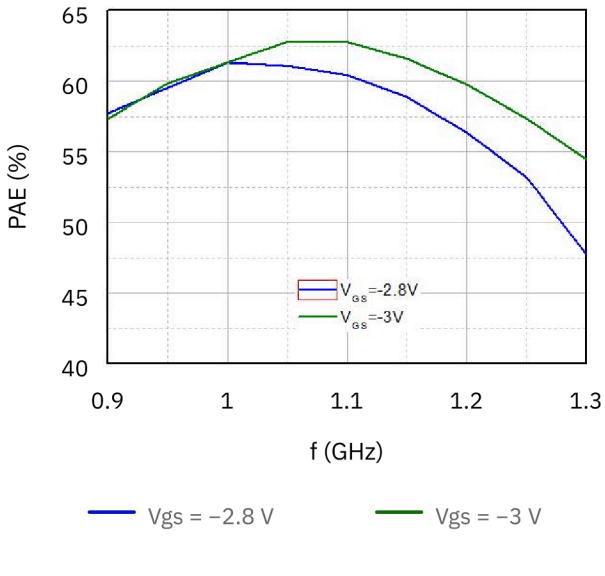
Pulsado — Potência de saída; Eficiência de potência adicionada; Corrente dinâmica de dreno; Eficiência de potência adicionada (diferentes polarizações de porta).

Notas da figura: Vd = 28 V; Vg = −2.8 V; D = 10%.



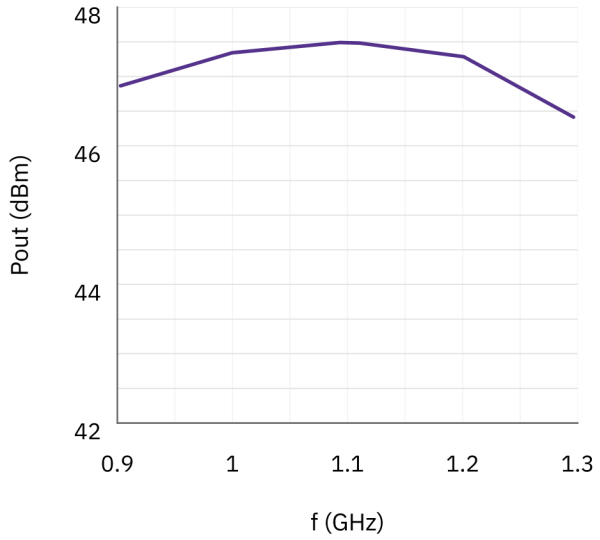


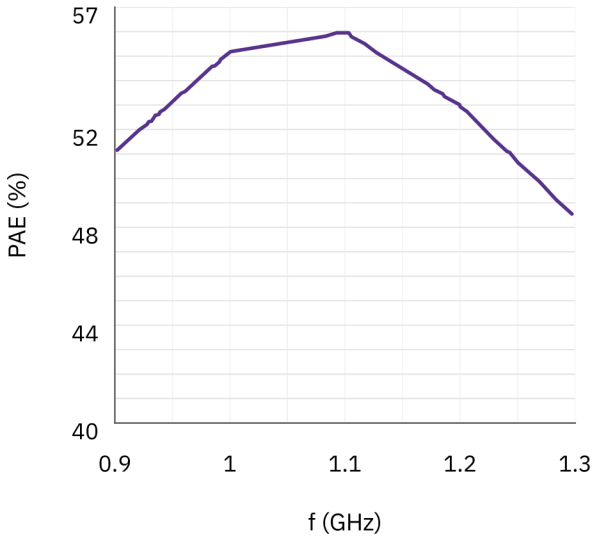


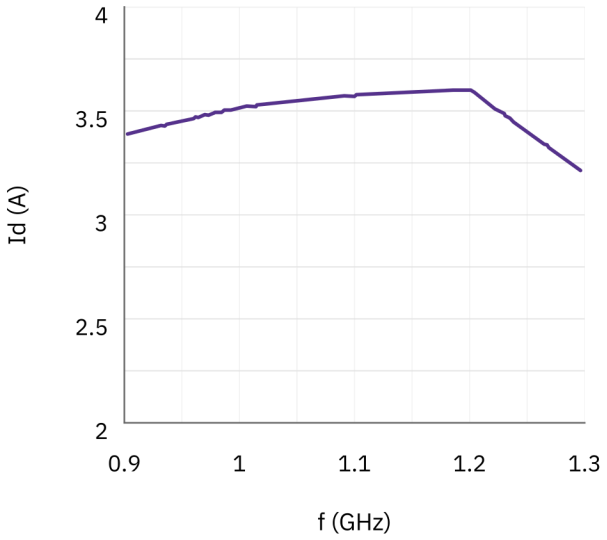


Onda contínua (CW) — Potência de saída; Eficiência de potência adicionada; Corrente dinâmica de dreno.

Notas da figura: Vd = 28 V; Vg = −2.8 V. As leituras são aproximadas.







Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.